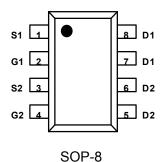


SHEN ZHEN FINE MAD ELECTRONICS GROUP CO., LTD.

9926A(文件编号: S&CIC1368)

20V N 沟道增强型 MOS 场效应管

 $R_{DS}(ON)$, Vgs@2.5V, $Ids@5.0A = 42m\Omega$ $R_{DS}(ON)$, Vgs@4.5V, $Ids@6.0A = 30m\Omega$



绝对最大额定值 (T_A=25℃,除非另有注明)

参数		符号	最大值	单位	
漏源极电压		V_{DS}	20	V	
栅源极电压		V_{GS}	±10	V	
连续漏电流	T _A =25℃	- I _D	6	А	
	T _A =70 °C		4.2		
脉冲漏电流		I _{DM}	20		
功耗	T _A =25℃	P _D	2	W	
	T _A =70 ℃		1.28		
温度范围		T _J , T _{STG}	-55~150	$^{\circ}$ C	

热特性

参数		符号	典型值	最大值	单位
最大管结温度	T≤10S	D	56	56 62.5	
最大管结温度	Steady -State	R _{θJA}	81	110	°C/W
最大热阻	Steady -State	R ₀ JL	40	48	°C/W



深圳市富满电子集团股份有限公司 SHEN ZHEN FINE MAD ELECTRONICS GROUP CO., LTD.

9926A(文件编号: S&CIC1368)

20V N 沟道增强型 MOS 场效应管

电特性

(T」=25℃,除非另有注明)

参数	符号	测试条件	最小	典型	最大	单位	
静态部分							
漏源击穿电压	BV _{DSS}	V _{GS} = 0V,I _D = 250uA	20			V	
Drain-source 导通内阻	R _{DS(ON)}	V _{GS} = 4.5V,I _{DS} =6A		21	30	mΩ	
Drain-source 导通内阻	R _{DS(ON)}	V _{GS} = 2.5V,I _{DS} =5A		26	42	mΩ	
栅极阈值电压	V _{GS(th)}	V _{GS} = VGS,I _D = 250uA	0.5	0.75	1	V	
漏源极漏电流	I _{DSS}	V _{DSS} = 20V,V _{GS} = 0V			1	uA	
栅源极漏电流	I _{GSS}	$V_{GS} = \pm 12V, V_{DS} = 0V$			±100	nA	
动态部分							
栅极总电荷	Q _G			6.24	8.11	nC	
栅源电荷	Q _{GS}	V _{DS} = 10V,I _D = 6A V _{GS} = 4.5V		1.64	2.13		
栅漏电荷	Q _{GB}			1.34	1.74		
开始延迟时间	T _{d(on)}	$V_{DD} = 10V, I_D = 6A$ $I_D = 1A, V_{GS} = 4.5V$		10.4	20.8	ns	
上升时间	Tr			4.4	8.8		
关闭延迟时间	T _{d(off)}			27.36	54.72		
下降时间	T _f			4.16	8.32	1	
输入电容	C _{iss}			522.3			
输出电容	Coss	$V_{DS} = 8V, V_{GS} = 0V$ f = 1.0MHz		98.48		pF	
反向传输电容	C _{rss}	1 - 1.UIVII IZ		74.69			
源漏极二极管							
二极管最大正向电流	Is				1.7	Α	
二极管正向电压	V _{SD}	I _S = 1.7A,V _{GS} = 0V		0.74		V	



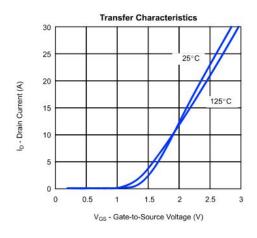
SHEN ZHEN FINE MAD ELECTRONICS GROUP CO., LTD.

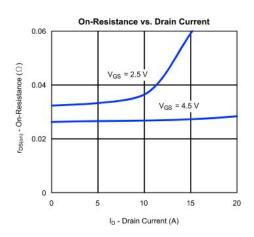
9926A(文件编号: S&CIC1368)

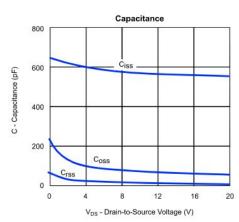
20V N 沟道增强型 MOS 场效应管

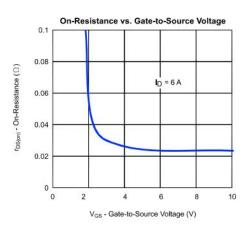
曲线图

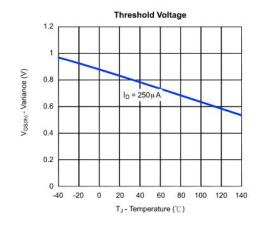
Typical Characteristics (TJ =25℃ Noted)

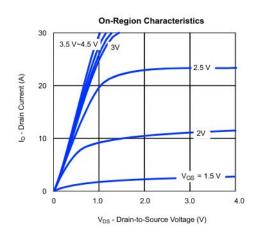












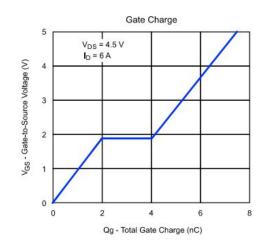


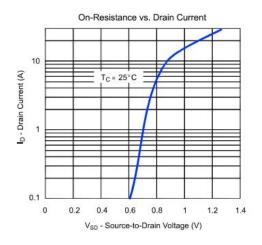
SHEN ZHEN FINE MAD ELECTRONICS GROUP CO., LTD.

9926A(文件编号: S&CIC1368)

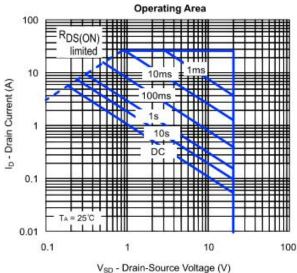
20V N 沟道增强型 MOS 场效应管

Typical Characteristics (TJ =25℃ Noted)

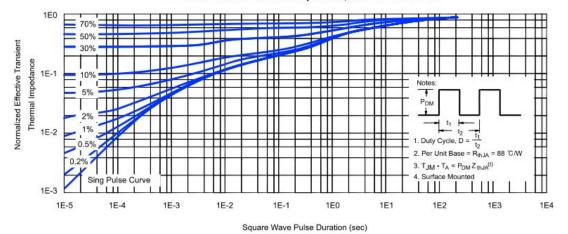




Maximum Forward Biased Safe



Normalized Thermal Transient Impedance, Junction-to-Ambient





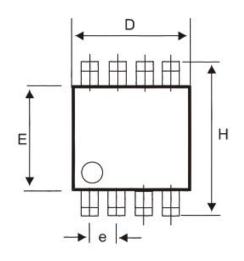
SHEN ZHEN FINE MAD ELECTRONICS GROUP CO., LTD.

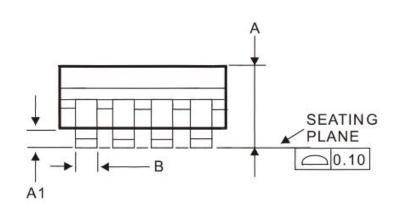
9926A(文件编号: S&CIC1368)

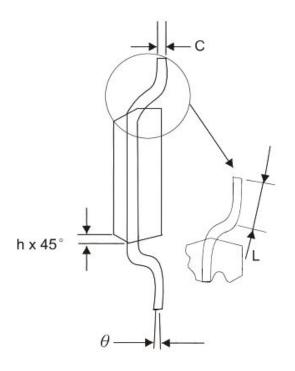
20V N 沟道增强型 MOS 场效应管

包装尺寸

SOP-8 Package Outline







DIM	MILLIMETERS			
	MIN	MAX		
Α	1.35	1.75		
A1	0.10	0.25		
В	0.35	0.49		
С	0.18	0.25		
D	4.80	5.00		
E	3.80	4.00		
е	1.27 BSC			
Н	5.80	6.20		
h	0.25	0.50		
L	0.40	1.25		
θ	0°	7°		